

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 295

Общие данные

Микросхемы серии 295 предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии 295

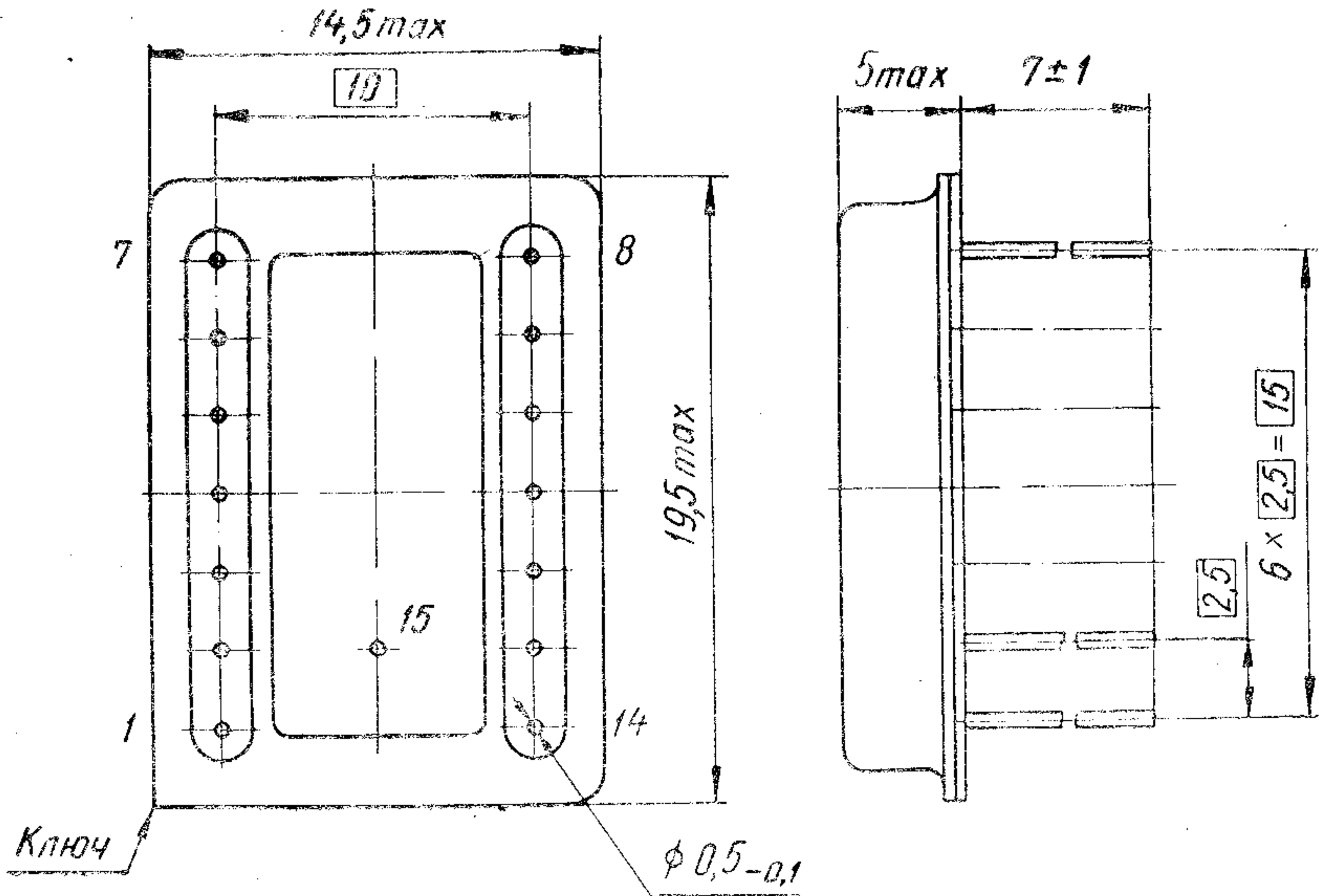
Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение	Обозначение документа на поставку
295АГ1А	Оптоэлектронный одновибратор	6К0.347.096 ТУ
295АГ1Б		6К0.347.096 ТУ
295АГ1В		6К0.347.096 ТУ
295АГ1Г		6К0.347.096 ТУ
295АГ1Д		6К0.347.096 ТУ

Микросхемы выполнены в прямоугольном корпусе 151.14-5.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 295

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 4,5 г

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)

5000 (500)

Акустический шум:

диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	170

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 295

Общие данные

Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	5 (665)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °С	70
Пониженная температура среды, °С	минус 10
Изменения температуры среды, °С	от минус 60 до +70
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч	15 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Не допускается изгиб выводов ближе 2 мм от края корпуса микросхемы с радиусом закругления менее 1 мм. Запрещается кручение выводов микросхемы вокруг оси и изгиб выводов в плоскости корпуса микросхемы.

При лужении выводов методом погружения в расплавленный припой температура расплавленного припоя должна быть не более 250°C, время лужения — не более 2 с, расстояние от корпуса до зеркала (по длине вывода) — не менее 1 мм, допустимое количество погружений — не более двух (за одно погружение принимается полное облуживание всех выводов), интервал между двумя погружениями — не менее 5 мин.

Пайка выводов микросхем допускается на расстоянии не менее 1 мм от корпуса. Рекомендуются состав флюса: 20%-ный раствор канифоли в этиловом спирте. Температура припоя при пайке не должна превышать 250°C, рекомендуемый припой ПОС-61.

Возможное использование микросхем после монтажа и демонтажа на платы — 2 раза.

Во избежание ложных срабатываний длительность входных сигналов должна быть меньше длительности сигналов, формируемых на выходе микросхемы; максимальная скорость нарастания напряжения питания не должна превышать 10 В/мкс; не допускается изменение напряжения на входных выводах (относительно выходных) со скоростью большей 10^8 В/с. При наличии паразитной монтажной емкости между входными и выходными выводами микросхемы допустимая скорость изменения напряжения на входных выводах должна быть соответственно уменьшена.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В:	
для микросхемы 295АГ1А	$12 \pm 10\%$
» микросхем 295АГ1 (Б, В)	$27 \pm 10\%$
» » 295АГ1 (Г, Д)	$48 \pm 10\%$
Выходной импульсный ток при $\tau_{и} = 2$ мс, $K_3 = 20$, мА, не более:	
для микросхем 295АГ1 (А, Б)	50
» » 295АГ1 (В, Г)	100
» микросхемы 295АГ1Д	200
Ток утечки на выходе, мкА, не более	10
Ток включения, мА, не более	20
Минимальное напряжение включения, В, не более	3,6
Остаточное напряжение, В, не более	2,5
Сопротивление гальванической развязки, Ом, не менее	10^8

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное допустимое напряжение включения, В	5,25
Максимальное допустимое напряжение между вхо- дом и выходом, В	100
Максимально допустимый выходной импульсный ток, мА:	
для микросхем 295АГ1 (А, Б)	50
» » 295АГ1 (В, Г)	100
» микросхемы 295АГ1Д	200
Максимальная допустимая рассеиваемая мощность, мВт	500
Максимальная допустимая скорость нарастания напряжения питания при температуре от минус 10 до $+70^\circ\text{C}$, В/мкс	50